

Правила оформления рукописи статьи

Авторам следует соблюдать следующую структуру текста рукописи:

аннотация
ключевые слова статьи
введение с обоснованием решаемой задачи,
цель и задача работы, методы исследования,
результаты исследований, обсуждение результатов исследований,
выводы или заключение,
список литературы.

Объем статьи до 10 полных страниц.

Рабочий язык – **русский и английский**.

Текстовый редактор – **Microsoft Word 2003, 2007** или новее.

Формат страниц – **A4**. Шрифт – **Times New Roman**. Размер шрифта – **12** пт.

Интервал – **одинарный**.

Поля: левое – **30** мм, правое – **15** мм, сверху – **20** мм, снизу – **20** мм,

отступ первой строки абзаца – **1,25** см.

Требуется **полное** заполнение страницы.

Рисунки только в черно-белом варианте, размер шрифта подписей к рисункам – **12** пт.

Обозначения на рисунке должны быть **четкими** с соблюдением **пропорции** цифровых обозначений.

Правила оформления шапки статьи: отступить от границы верхнего поля **4 строки**; на следующей строке перечислить **инициалы и фамилии авторов** через запятую; через строку ниже **прописными** буквами написать **название доклада**; через строку перечислить название **организаций** и **город** (по одной организации на строку); на следующей строке перечислить **e-mail** авторов (по желанию) через запятую; через строку печатать ключевые слова на следующей строке краткую аннотацию, через строку продублировать вышеуказанные данные на английском языке, далее через строку печатать основной текст доклада. *Пример оформления:*

пустая строка
пустая строка
пустая строка
пустая строка

О.В. Гончарова, А.Ю. Опарин
пустая строка

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ

пустая строка

Северо-Кавказский филиал ордена Трудового Красного Знамени федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский технический университет связи и информатики», Ростов-на-Дону, Россия

пустая строка

Ключевые слова: информационные технологии, новые технологии, уровень проникновения широкополосного доступа, информационное общество.

В статье рассмотрены проблемы и актуальные тенденции современного информационного общества, представлены основные задачи отрасли инфокоммуникаций, определены основные тенденции в формировании инфокоммуникационных технологий в России на 2016-2020гг.

пустая строка

O.V. Goncharova, A.Yu. Oparin
пустая строка

THE DEVELOPMENT OF THE ICT INDUSTRY IN RUSSIA

пустая строка

North Caucasus branch of Moscow Technical University of Communications and Informatics, Rostov-on-Don, Russia

пустая строка

Keywords: information technology, new technologies, penetration rate of broadband access, information society.

The article considers problems and trends of the modern information society, presented the main challenges of the telecommunications industry and identifies main trends in the formation of information and communication technologies in Russia to 2016-2020y.

Пример оформления шапки статьи, если авторы работают в разных организациях или один из авторов работает в двух организациях представлен ниже.

О.В. Гончарова¹, А.Ю. Опарин^{1,2}
пустая строка

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ

пустая строка

Северо-Кавказский филиал ордена Трудового Красного Знамени федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Московский технический университет связи и информатики»,
Ростов-на-Дону, Россия¹

Донской государственный технический университет,
Ростов-на-Дону, Россия²

пустая строка

Ключевые слова: информационные технологии, новые технологии, уровень проникновения широкополосного доступа, информационное общество.

В статье рассмотрены проблемы и актуальные тенденции современного информационного общества, представлены основные задачи отрасли инфокоммуникаций, определены основные тенденции в формировании инфокоммуникационных технологий в России на 2016-2020гг.

Пример составления списка литературы:

(привести полные сведения согласно ГОСТа и требованиям ВАК)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Ненашева Е.А.* Керамические материалы для электронной техники СВЧ. // «INTERMATIC – 2004» / Материалы Международной НПК, 9-12 июня 2003 г. Москва. – М.: МИРЭА, 2003, с. 17-19.
2. *Васильев А.Г., Хорин И.А.* Силициды в технологии многоуровневой металлизации УБИС. // «ПЛЕНКИ-2002» / Материалы Международной НПК, 26-30 ноября 2002 г. Москва. – М.: МИРЭА, 2002, ч. 2., с. 105-110.
3. *Вдовенков В.А., Прокофьева С.П., Усачева Т.Н.* Быстродействующие приемники с контактами на барьерах Шоттки. // Журнала технической физики. – 1990, т.60, № 2, с. 213-216.
4. *Лучников А.П., Класов В.Н.* Стабильность заряда тонкопленочных электретных покрытий. // Техника средств связи, сер. ЛОСС. –1990, № 1, с. 34-40.
5. *Gunther P.* Charging, Long-term Stability and TSD Measurements of SiO₂ Electrets. // IEEE Trans. on Electr. Insulation. –1989, v. 24, № 3, p. 430-442.
6. *Kuhel W., Franz J., Hohm D., Heb G.* Silucon Subminiature for Airborne Sound. // Acustica. – 1991, v.73, p. 90-99.
7. *Семенова И.А.* Тонкие пленки углерода: выращивание пучками заряженных частиц, фазообразование, строение и свойства. // Автореф. канд. техн. наук. – Улан-Уде: БНЦ СО РАН. – 24 с.

Внимание!

Рукопись доклада, оформленная без соблюдения требований Оргкомитета, к печати не допускается!